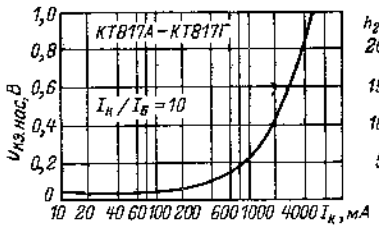
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leqslant 1$ кОм, $T_к = 233 \div 373$ К:	
КТ817А	40 В
КТ817Б	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	100 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $T_к = 233 \div 373$ К	5 В
Постоянный ток коллектора при $T_к = 233 \div 373$ К	3 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_и \leqslant 20$ мс, $Q \geqslant 100$, $T_к = 233 \div 373$ К	6 А
Постоянный ток базы при $T_к = 233 \div 373$ К	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
с теплоотводом при $T_к = 233 \div 298$ К	25 Вт
без теплоотвода при $T = 233 \div 298$ К	1 Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 233 до $T_к = 373$ К

Примечания: 1. Постоянная рассеиваемая мощность при $T_к > 298$ К уменьшается линейно на 0,2 Вт/К с теплоотводом и на 0,01 Вт/К без теплоотвода.

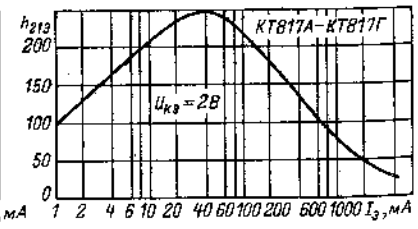
2. Пайку выводов разрешается проводить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

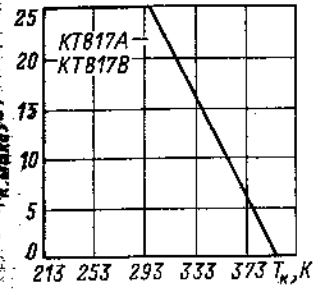
При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент при нажатии не должен превышать 70 Н·см.



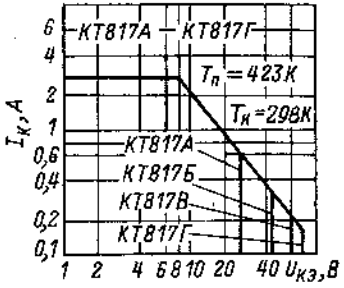
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.



Область максимальных режимов.

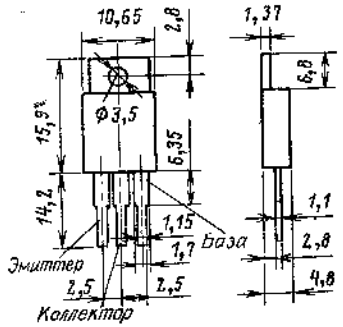
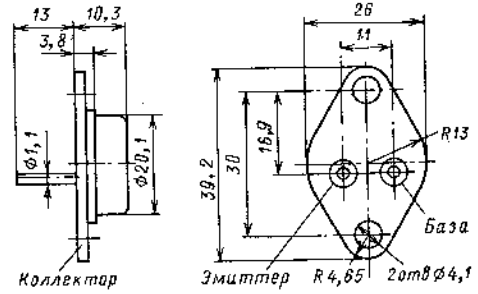
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ

Транзисторы кремниевые мезатаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные мощные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях импульсных схемах.

Транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (вариант 1), транзисторы 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ – в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами (вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзисторов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г не более 3 г, транзисторов 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ не более 20 г.

Вариант 1



Вариант 2